

96-0299

Rezumat:

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată pentru obținerea materialelor electronicii semiconductoare.

Procedeul de obținere a structurilor epitaxiale stratificate include creșterea succesivă a straturilor epitaxiale de diferiți compuși în fluxuri de gaze corespunzătoare, după creșterea fiecărui strat suprafața de creștere se învâluie cu un flux de gaz inactiv până la creșterea stratului următor.

Instalația pentru obținerea structurilor epitaxiale stratificate conține reactor cu camere de creștere a straturilor epitaxiale legate cu tijă, nod de fixare a substraturilor, mecanism de acționare a camerelor de creștere a straturilor epitaxiale. Nodul de fixare a substraturilor este executat în formă de polițe plasate în țevi situate una deasupra alteia la o distanță ce nu depășește lungimea minimă de difuzie a moleculelor gazului utilizat.

Rezultatul tehnic constă în asigurarea posibilității de obținere a structurilor epitaxiale stratificate cu profil abrupt.

Revendicări: 2

Figuri: 4